

# 2017年秋季学術講演会 分科企画シンポジウム

応用物理学会

シリコンテクノロジー分科会

Silicon Technology Division



シリコンプロセスは、実装技術との境界が消えつつある一方で限界もあります。さらなる革新のためにサブnmから $\mu\text{m}$ をカバーするシンプルでrobustなプロセスが求められています。本シンポジウムではいわゆるドライ技術、ウェット技術の役割を見直し、新しいマルチスケールプロセスの提案について検討を行います。ふるってのご参加をお待ちしています。

## マルチスケールプロセスへの挑戦 —ドライかウェットかそれとも…—

9/7(木)  
開催

Challenges for 'multi-scale' processing — dry, wet, or else…

日時：2017年9月7日（木） 13：45～17：25

場所：福岡コンベンションセンター 会場C19

13:45 マルチスケールプロセスへの挑戦 - シンポジウムの開催にあたって -

13:50 超微細化と超三次元化の時代の配線考 (招待講演)

14:20 10 nmノード以降対応のアトミックレイヤーエッチング (招待講演)

14:50 分子動力学の目でみたウェットとドライの物理 (招待講演)

15:20 微小空間におけるウェットエッチング挙動の考察

真田 俊之 (静岡大)

磯林 厚伸 (東芝)

野尻 一男 (Lam)

山口 康隆 (阪大)

奥山 敦 (ソニー)

15:50 マルチスケール超臨界媒体の半導体プロセス応用 (招待講演)

16:20 ナノからマイクロにわたるめっきプロセス (招待講演)

16:50 無電解メッキ法で作製した微細配線の電気特性

17:05 触媒エッチングによる新規ダイシングプロセスの開発

17:20 クロージングリマーク

近藤 英一 (山梨大)

新宮原 正三 (関西大)

日恵野 敦 (東芝)

小幡 進 (東芝)

上野 和良 (芝工大)

本シンポジウムに関するお問い合わせ先  
世話人 真田俊之 (静岡大学)  
sanada.toshiyuki@shizuoka.ac.jp

シリコンテクノロジー分科会 多層配線システム研究委員会  
& 界面ナノ電子化学研究会 共同企画